

### 关键指标

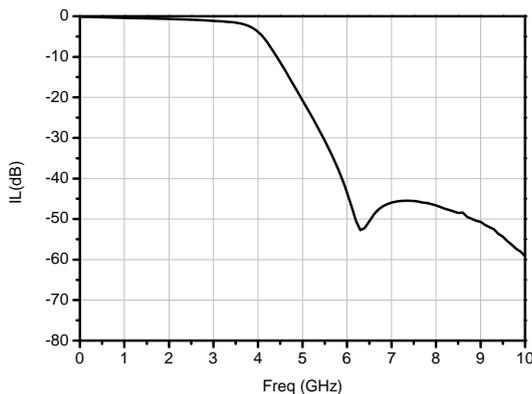
通带频率: DC~3.5GHz  
 插入损耗: 1.1dB@3GHz, 1.6dB@3.5GHz  
 阻带衰减: 20dB@5GHz, 40dB@5.9GHz  
 芯片尺寸: 1.4mm×0.6mm

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25℃)

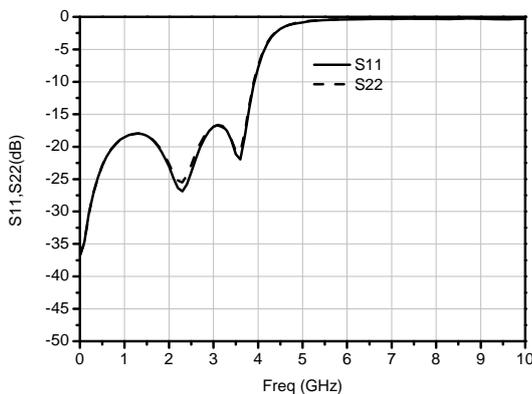
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~3.5		
输入回波损耗	-	18	-
输出回波损耗	-	18	-
插入损耗(dB)	-	1.6	-
阻带衰减@5GHz	-	20	-
阻带衰减@5.9GHz	-	40	-

### 典型测试曲线

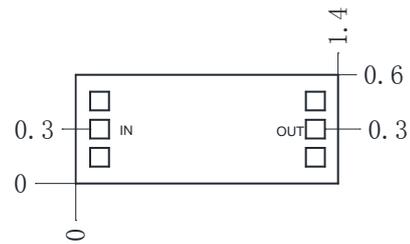
插入损耗



回波损耗



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。